

- 13. Pretende realizar-se uma impedância de valor $1500\angle -41^\circ\Omega$ a 600Hz. Para o fazer podemos usar os seguintes dois elementos de circuito ligados em série:
- a) Resistência de 1132Ω e condensador de $0.27\mu F$, b) Resistência de 984Ω e bobina de 300mH. c) Resistência de 1132Ω e bobina de 261mH; d) Resistência de 984Ω e condensador de $0.15\mu F$.
- 14- Considere a configuração de lâmpadas da fig. 9 ligada a uma fonte de tensão de valor V. Assumindo todas as lâmpadas iguais, as que irão apresentar um brilho mais intenso serão as lâmpadas

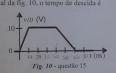




Fig. 9 - questão 14

- 15 Para o sinal da fig. 10, o tempo de descida é

- a) 60ns; b) 10ns; c) 16ns; d) 20ns.



- 16 No circuito da fig. 11 considere que a tensão de condução dos diodos é 0.7V. O valor de I é: 0.0.2mA; 0.0.2mA; 0.0.12mA; 0.0.12mA; 0.0.93mA. $\begin{array}{c|c} & \text{ord} & \text{ord} & \text{ord} \\ \hline & D_1 \\ \hline & D_2 \\ \hline & & \\ & & \\ \hline & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ \end{array}$ 1 ≥ 6 kΩ 3 V = =

Fig. 11 - questão 16

- 17)- No circuito da fig. 12 considere que a tensão de condução do diodo é 0.7 V. O diodo Zener é de 12 V. Se Vi for um tensão alternada sinusoidal com 16 V de valor eficaz, o valor máximo da corrente no Zener será, aproximadamente, a) 28.3 m.4; b) 4.1 m.4; c) 12.3 m.4; d) 13.3 m.4.



Fig. 12 - questão 17

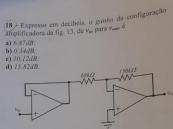


Fig. 13 - questão 18

- 19 Um aluno de SSE montou e testou em laboratório o amplificador ilustrado na fig. 14 tendo observado na saída um sinal com distorção. Uma solução possível para evitar a distorção consiste em:

- para evitar a distorção consiste em:

 a) Reduzir o valor de R_1 ;
 b) Reduzir o valor de R_2 ;
 c) Reduzir R_1 e R_1 na mesma proporção
 d) Trocar as entradas + e do OpAmp.

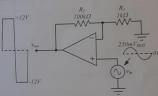


Fig. 14 - questão 19

- 20- Para um transistor MOS (um MOSFET) de canal N a funcionar como interruptor, é verdade que
- a funcionar como interruptor, é verdade que a) O transistor torna-se condutor quando a tensão entre dreno e fonte ultrapassar, aproximadamente, θ , TV. (b) O transistor torna-se condutor, entre dreno e fonte, quando a tensão na fonte excede a da porta em, pelo menos, V_{ir} . c) O transistor tem a menor resistência entre dreno e fonte quando está na região de saturação; (a)/O transistor torna-se condutor, entre dreno e fonte, quando a tensão na fonte é inferior à da porta em, pelo menos, V_{T} .